2020年1月22日

**信越化学 窒化ガリウム(GaN) 基板および関連製品の開発を本格化**

信越化学工業株式会社（本社：東京、社長：斉藤恭彦、以下信越化学）は、このたびQromis, Inc.（本社：米カリフォルニア州、CEO：Cem Basceri、以下Qromis社）との間で、同社が保有するGaN（窒化ガリウム）基板関連技術についてライセンス契約を締結し、GaN基板および関連製品の開発を本格化します。

信越化学は、半導体シリコンウエハーを製造する子会社の信越半導体（本社：東京、社長：秋谷文男）とともに、パワー半導体と高周波半導体向けに通常のシリコンウエハーに加え、Silicon on Insulator（SOI）ウエハーやGaN on Siliconウエハー等の基板を開発し、販売してきました。これらの製品群をさらに拡充するとともに、Qromis社の技術を用いてGaN基板および関連製品の品揃えを行い、複数の解を提供することで顧客の要望に応えていきます。

GaNを用いた半導体は、電動自動車等のモビリティーの進化、５Gやデジタライゼーションなどで求められる高デバイス特性と省エネルギーという相反する課題を解決できるデバイスとして、今後需要が大きく拡大することが期待されています。

信越化学および信越半導体をはじめとする当社グループは、大口径GaN関連製品を供給することで、時代の要請である、エネルギーを効率的に利用できる持続可能な社会の実現に貢献してまいります。

この件に関するお問い合わせは

信越化学工業株式会社　広報部　小石川

Tel: 03-3246-5091　FAX: 03-3246-5096

e-mail：sec-pr@shinetsu.jpまでお願いします